

Polar™ HiPerFET™ Power MOSFET

IXFA14N60P
IXFP14N60P
IXFH14N60P

$V_{DSS} = 600V$
 $I_{D25} = 14A$
 $R_{DS(on)} \leq 550m\Omega$

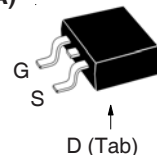
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated



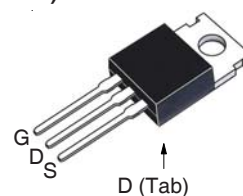
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	600	V
V_{DGR}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	600	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^{\circ}C$	14	A
I_{DM}	$T_C = 25^{\circ}C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	42	A
I_A	$T_C = 25^{\circ}C$	14	A
E_{AS}	$T_C = 25^{\circ}C$	900	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^{\circ}C$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^{\circ}C$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^{\circ}C$
T_{JM}		150	$^{\circ}C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^{\circ}C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^{\circ}C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^{\circ}C$
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb
M_d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13 / 10	Nm/lb.in
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^{\circ}C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	600		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 2.5mA$	3.0		5.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^{\circ}C$			5 μA 500 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			550 m Ω

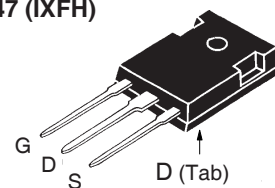
TO-263 (IXFA)



TO-220 (IXFP)



TO-247 (IXFH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Low $R_{DS(ON)}$ and Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^{\circ}\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	7	13	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2500	pF
C_{oss}			215	pF
C_{rss}			13	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 10\Omega$ (External)		23	ns
t_r			27	ns
$t_{d(off)}$			70	ns
t_f			26	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		36	nC
Q_{gs}			16	nC
Q_{gd}			12	nC
R_{thJC}				0.42 $^{\circ}\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-220		0.50	$^{\circ}\text{C/W}$
	TO-247		0.21	$^{\circ}\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^{\circ}\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			14 A
I_{SM}	Repetitive, pulse Width Limited by T_{JM}			42 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 14\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$			200 ns
Q_{RM}			600	nC
I_{RM}			6	A

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692	7,063,975B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

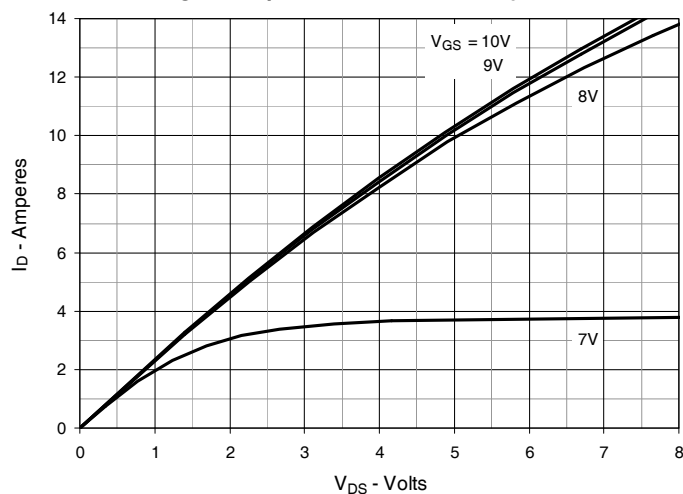


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

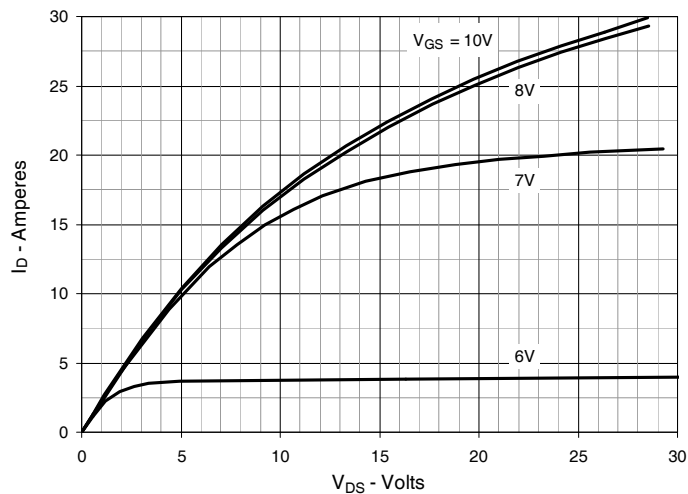


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

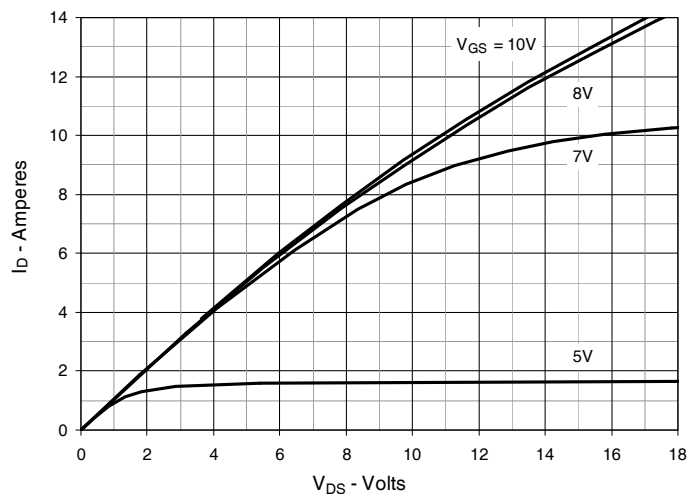


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7\text{A}$ Value vs. Junction Temperature

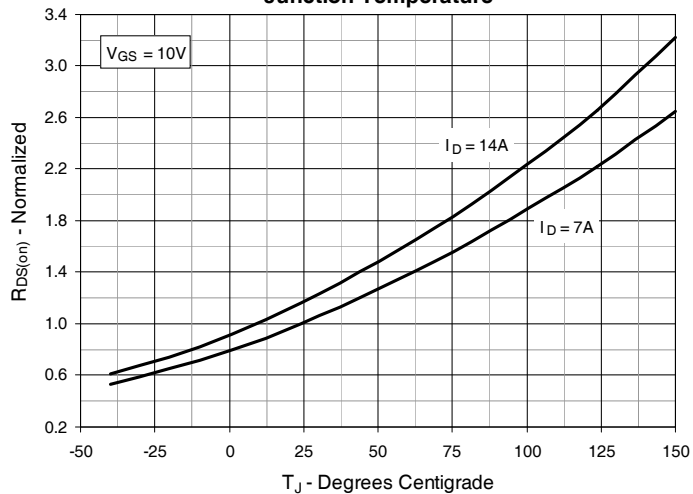


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 7\text{A}$ Value vs. Drain Current

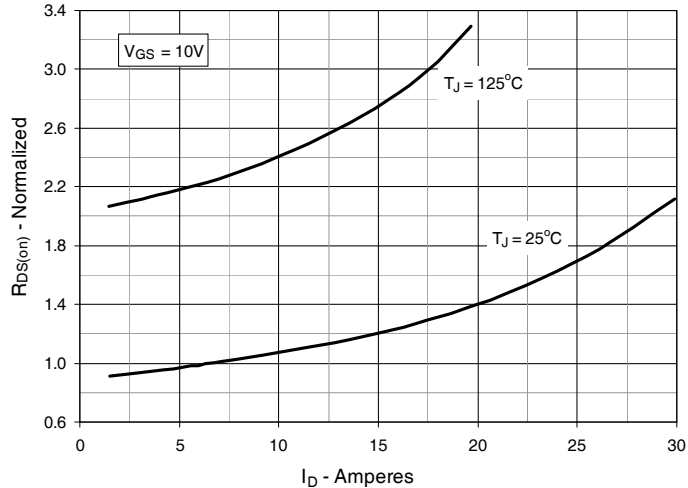


Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

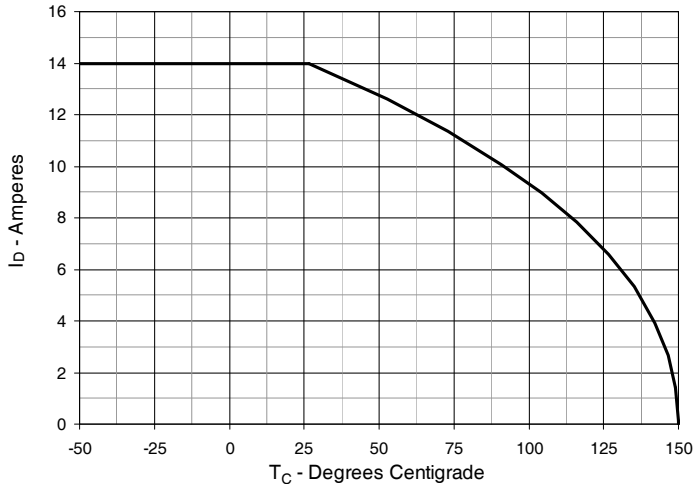


Fig. 7. Input Admittance

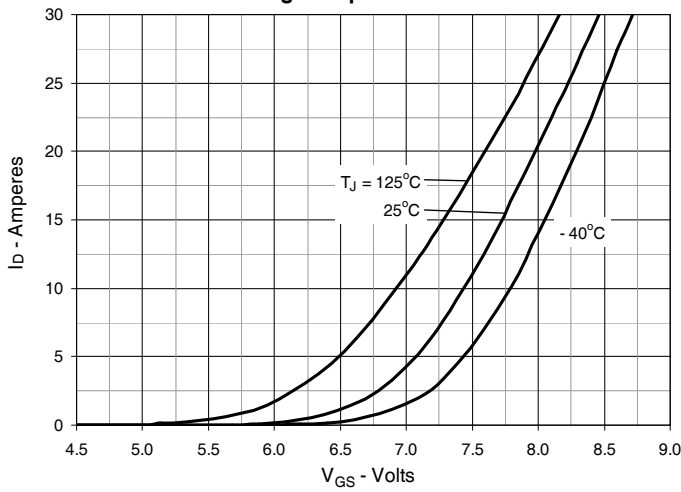


Fig. 8. Transconductance

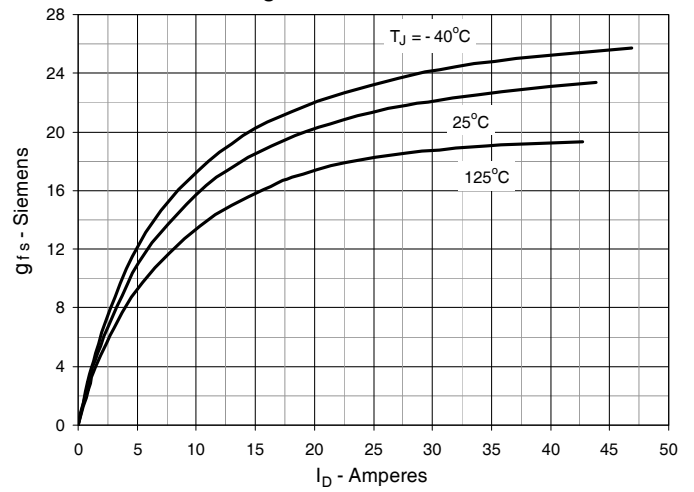


Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

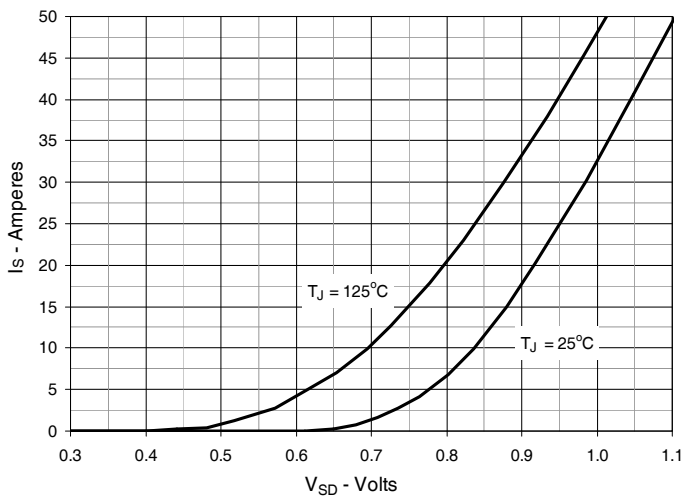


Fig. 10. Gate Charge

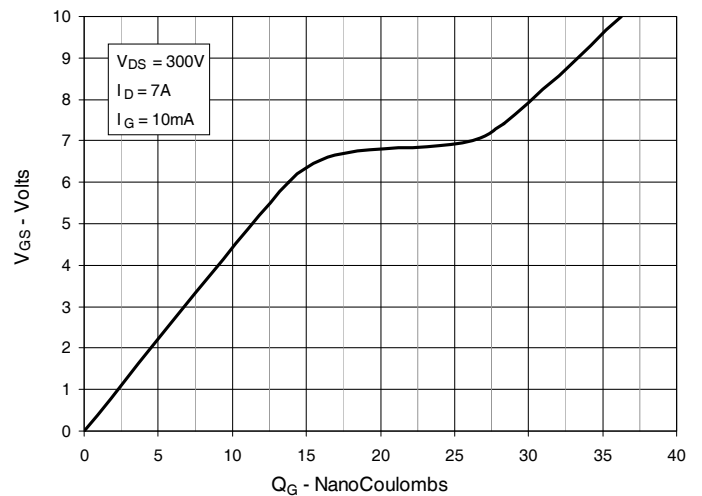


Fig. 11. Capacitance

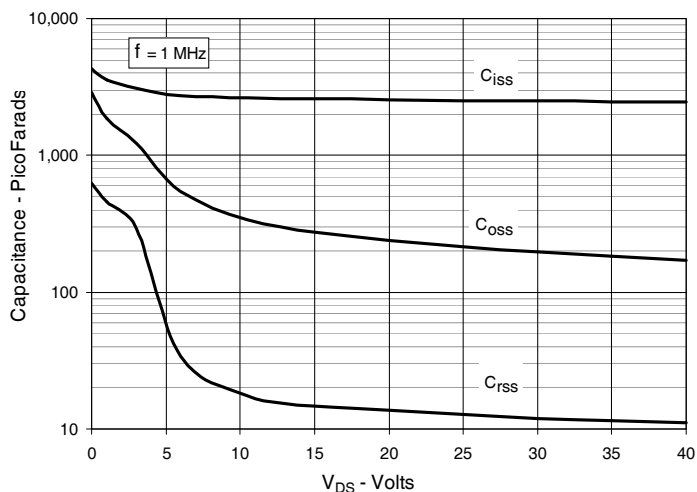


Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area

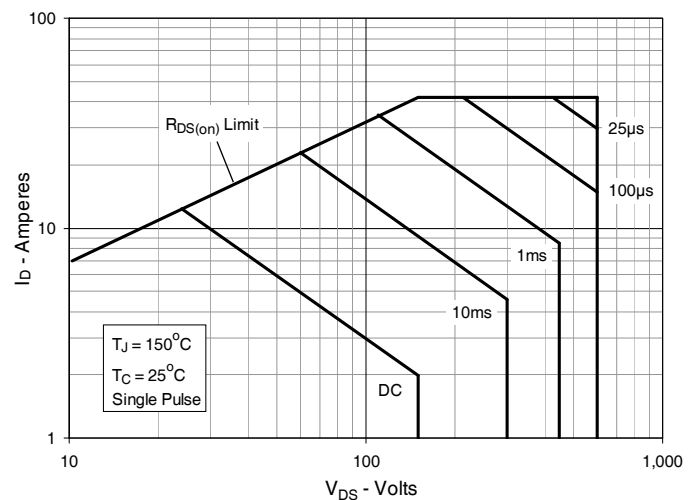
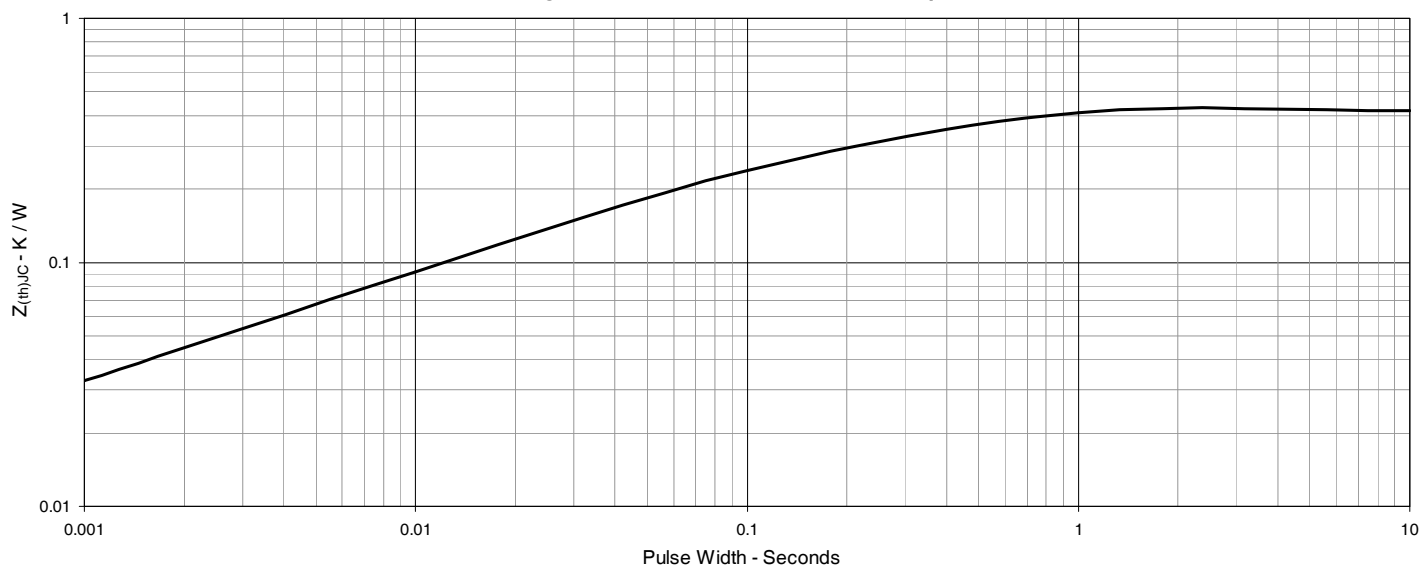
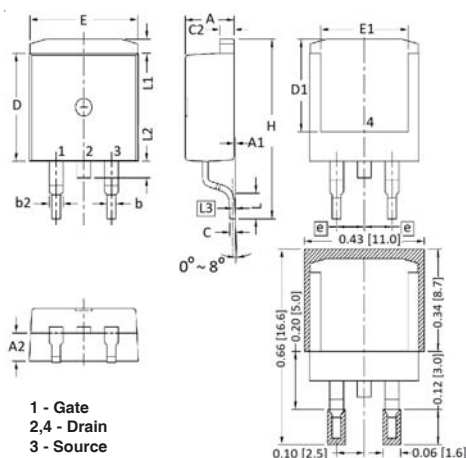


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance

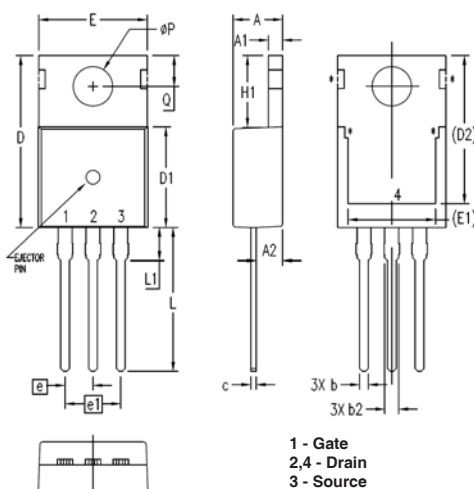


TO-263 Outline



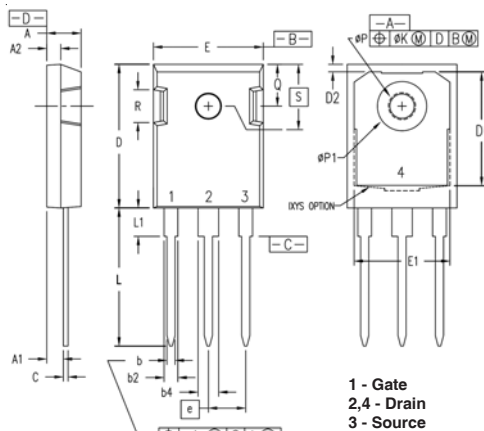
SYM	INCHES		MILLIMETER	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.185	4.30	4.70
A1	.000	.008	0.00	0.20
A2	.091	.098	2.30	2.50
b	.028	.035	0.70	0.90
b2	.046	.060	1.18	1.52
C	.018	.024	0.45	0.60
C2	.049	.060	1.25	1.52
D	.340	.370	8.63	9.40
D1	.300	.327	7.62	8.30
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.270	.330	6.86	8.38
e	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.580	.620	14.73	15.75
L	.075	.105	1.91	2.67
L1	.039	.060	1.00	1.52
L2	—	.070	—	1.77
L3	.010 BSC		0.254 BSC	

TO-220 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.169	.185	4.30	4.70
A1	.047	.055	1.20	1.40
A2	.079	.106	2.00	2.70
b	.024	.039	0.60	1.00
b2	.045	.057	1.15	1.45
c	.014	.026	0.35	0.65
D	.587	.626	14.90	15.90
D1	.335	.370	8.50	9.40
(D2)	.500	.531	12.70	13.50
E	.382	.406	9.70	10.30
(E1)	.283	.323	7.20	8.20
e	.100 BSC		2.54 BSC	
e1	.200 BSC		5.08 BSC	
H1	.244	.268	6.20	6.80
L	.492	.547	12.50	13.90
L1	.110	.154	2.80	3.90
ØP	.134	.150	3.40	3.80
Q	.106	.126	2.70	3.20

TO-247 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b2	.075	.087	1.91	2.20
b4	.115	.126	2.92	3.20
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
D1	.650	.690	16.51	17.53
D2	.035	.050	0.89	1.27
E	.620	.635	15.75	16.13
E1	.545	.565	13.84	14.35
e	.215 BSC		5.45 BSC	
J	--	.010	--	0.25
K	--	.025	--	0.64
L	.780	.810	19.81	20.57
L1	.150	.170	3.81	4.32
ØP	.140	.144	3.55	3.65
ØP1	.275	.290	6.99	7.37
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.242 BSC		6.15 BSC	



Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А